

「グリーンイノベーション基金事業／次世代デジタルインフラの構築」実施予定先一覧

【研究開発項目 1】次世代パワー半導体デバイス製造技術開発

採択テーマ	実施予定先
8 インチ次世代 SiC MOSFET の開発	ローム株式会社
次世代高耐圧電力変換器向け SiC モジュールの開発	東芝デバイス&ストレージ株式会社※ 東芝エネルギーシステムズ株式会社
次世代パワー半導体デバイス製造技術開発(電動車向け)事業	株式会社デンソー
次世代高電力密度産業用電源(サーバ・テレコム・FA 等)向け GaN パワーデバイスの開発	東芝デバイス&ストレージ株式会社

【研究開発項目 2】次世代パワー半導体に用いるウエハ技術開発

採択テーマ	実施予定先
超高品質・8 インチ・低コスト SiC ウエハ開発	株式会社オキサイド※ Mipox 株式会社
高品質 8 インチ SiC 単結晶／ウエハの製造技術開発	セントラル硝子株式会社
次世代グリーンパワー半導体に用いる SiC ウエハ技術開発	昭和電工株式会社

【研究開発項目 3】次世代グリーンデータセンター技術開発

採択テーマ	研究開発内容	実施予定先
要素デバイス省力化、光配線技術、ディスアグリゲーション技術の開発	(1)光エレクトロニクス技術の開発 (1)-1 光電融合デバイス開発 (1)-2 光スマート NIC 開発 (2)光に適合したチップ等の高性能化・省エネ化技術の開発 (2)-1 省電力 CPU 開発 (2)-2 省電力アクセラレータ開発 (2)-4 広帯域 SSD 開発 (3)ディスアグリゲーション技術の開発	富士通株式会社※((1)-2、(2)-1) アイオーコア株式会社((1)-1) 富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社((1)-2) 京セラ株式会社((1)-2) 日本電気株式会社((2)-2、(3)) キオクシア株式会社((2)-4)
光に適合したチップ等の高性能化・省エネ化：不揮発メモリ開発	(2)光に適合したチップ等の高性能化・省エネ化技術の開発 (2)-3 不揮発メモリ開発	日本ゼオン株式会社

※実施予定先が複数あるテーマの幹事企業